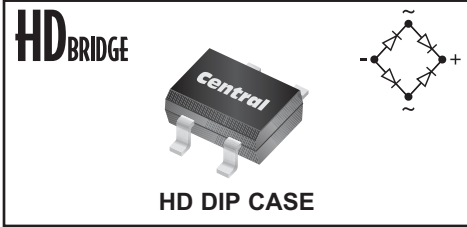


CBRHDSH1-100
SURFACE MOUNT
HIGH DENSITY
1 AMP SILICON
SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER



www.centrasemi.com



DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CBRHDSH1-100 is a full wave bridge rectifier in a durable epoxy surface mount molded case, designed for low voltage full wave rectification applications. The molding compound used in this device has UL flammability classification 94V-O.

MARKING CODE: CSH110

FEATURES:

- Low Leakage Current (40nA TYP @ V_{RRM})
- Low Forward Voltage Drop Schottky Diodes
- High 1.0A Current Rating

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

	SYMBOL		UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	100	V
DC Blocking Voltage	V_R	100	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	71	V
Average Forward Current	I_O	1.0	A
Peak Forward Surge Current	I_{FSM}	20	A
Power Dissipation	P_D	1.2	W
Operating Junction Temperature	T_J	-50 to +125	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	T_{stg}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	Θ_{JA}	85	$^\circ\text{C/W}$

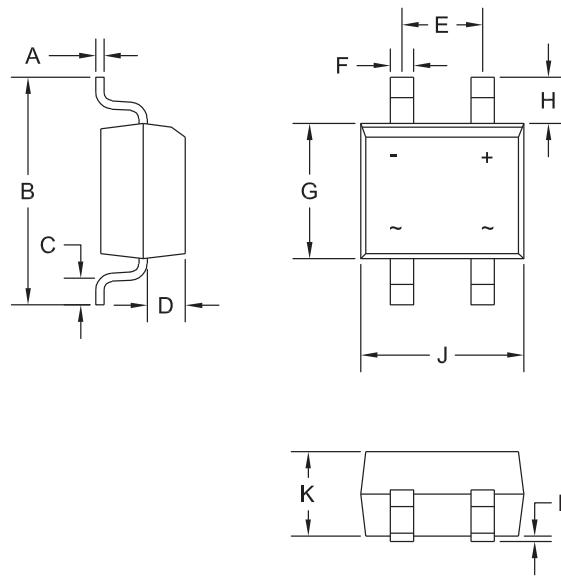
ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=100\text{V}$		0.04	10	μA
I_R	$V_R=100\text{V}, T_A=50^\circ\text{C}$			1.0	mA
I_R	$V_R=100\text{V}, T_A=100^\circ\text{C}$			20	mA
BV_R	$I_R=150\mu\text{A}$	100			V
V_F	$I_F=500\text{mA}$		615	700	mV
V_F	$I_F=1.0\text{A}$		690	750	mV
C_J	$V_R=4.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$		230		pF

CBRHDSH1-100
 SURFACE MOUNT
 HIGH DENSITY
 1 AMP SILICON
 SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER



HD DIP CASE - MECHANICAL OUTLINE



R2

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.006	0.014	0.15	0.35
B	-	0.275	-	7.00
C	0.027	0.043	0.70	1.10
D	0.035	0.051	0.90	1.30
E	0.090	0.106	2.30	2.70
F	0.019	0.031	0.50	0.80
G	0.150	0.165	3.80	4.20
H	0.051	0.067	1.30	1.70
J	0.177	0.193	4.50	4.90
K	0.090	0.106	2.30	2.70
L	0.000	0.008	0.00	0.20

HD DIP (REV: R2)

MARKING CODE: CSH110

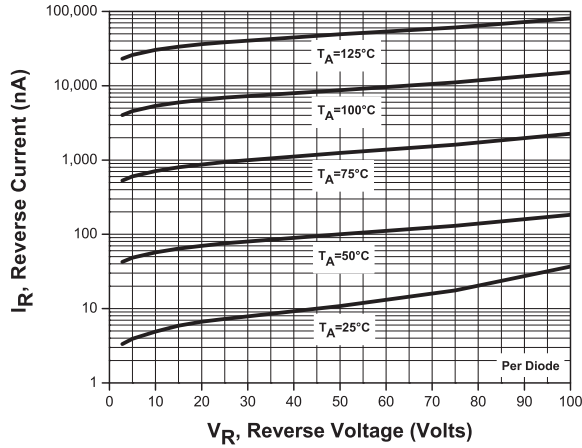
R6 (22-May 2012)

CBRHDSH1-100
SURFACE MOUNT
HIGH DENSITY
1 AMP SILICON
SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER

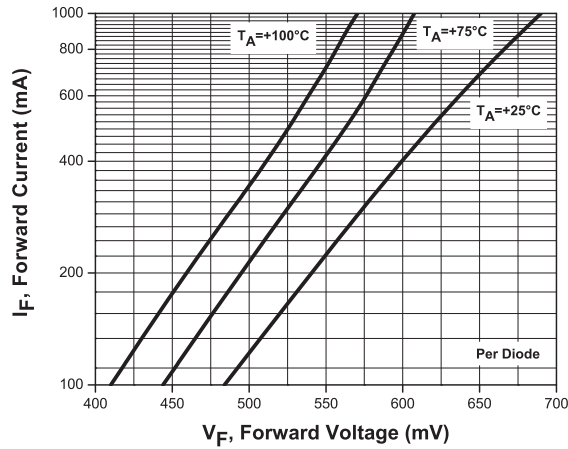


TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Typical Leakage Current



Typical Forward Voltage



R6 (22-May 2012)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9